

772S

硅 PNP 外延平面晶体管芯片(4 ")

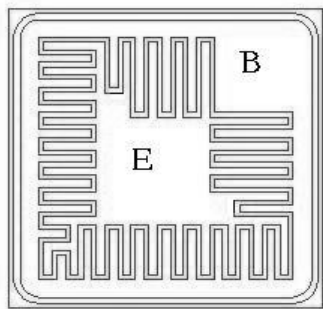
■用途:

- *中等功率放大器
- *中速开关应用

■特征:

- *集电极电流: 3A
- *有效图形数: 6700

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1050 μ m × 1050 μ m
压焊区尺寸	基区 310 μ m × 310 μ m 发射区 320 μ m × 320 μ m
芯片厚度	225 ± 10 μ m
锯片槽宽度	70 μ m
金属层	正面: Al 2.7 ± 0.2 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C =-100 μ A, I _E =0	-40		V
集电极--发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =-1mA, I _B =0	-30		V
发射极--基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =-100 μ A, I _C =0	-6		V
集电极--基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =-32V, I _E =0		-500	nA
发射极--基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =-4V, I _C =0		-500	nA
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =-2V, I _C =-1A	80	320	
集电极--发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =-2A, I _B =-0.2A		-0.5	V
特征频率	f _T	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A, f=10MHz	80		MHz